

BC

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-158593

(P2004-158593A)

(43) 公開日 平成16年6月3日 (2004. 6. 3)

(51) Int. Cl. ⁷

F 1

テーマコード (参考)

H 01 L 21/8238

H 01 L 27/08 3 2 1 D

4 M 1 0 4

H 01 L 21/28

H 01 L 21/28 3 0 1 S

5 F 0 4 8

H 01 L 21/336

H 01 L 29/78 3 0 1 G

5 F 1 1 0

H 01 L 27/092

H 01 L 29/78 3 0 1 P

5 F 1 4 0

H 01 L 29/423

H 01 L 29/78 6 1 7 M

審査請求 未請求 請求項の数 24 O L (全 22 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号

特願2002-322094 (P2002-322094)

(22) 出願日

平成14年11月6日 (2002. 11. 6)

(71) 出願人 000003078

株式会社東芝

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(74) 代理人 100083161

弁理士 外川 英明

(72) 発明者 松尾 浩司

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株

式会社東芝横浜事業所内

F ターム (参考) 4M104 AA01 AA09 BB02 BB04 BB19

BB20 BB21 BB22 BB23 BB24

BB25 BB26 BB27 BB28 BB38

CC05 DD03 DD37 DD43 DD75

DD78 DD83 DD84 EE03 EE09

EE14 EE16 EE17 GG10

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置及びその製造方法

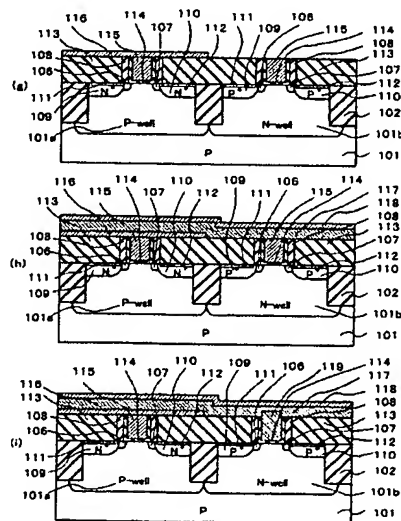
(57) 【要約】

【課題】しきい値電圧の制御が容易で、かつ、ゲート絶縁膜の信頼性が優れたゲート構造を備えた絶縁ゲート型 MISFET を含む半導体装置とその製造方法を提供することにある。

【解決手段】NチャネルMISFET領域とPチャネルMISFET領域とを形成し、NチャネルMISFETのゲート電極として第1の金属シリサイド膜115を、PチャネルMISFETのゲート電極として第2の金属シリサイド膜119をもつ構造とする。

まず、第1の金属シリサイド膜115をゲート電極領域に形成した後、PチャネルMISFET領域に第1の金属膜117を形成する。続いて熱処理を行うと、PチャネルMISFETのゲート電極上に形成された第1の金属膜117がその下の第1の金属シリサイド膜115と固相反応を起し、PチャネルMISFETのゲート電極は第2の金属シリサイド膜119に変換される。

【選択図】 図3



101:シリコン基板 101a:P型ウエル領域 101b:N型ウエル領域
102:電子分離領域 106, 107:エクステンション領域
108:側壁絶縁膜 109, 110:ソース及びドレイン領域
111, 112:第1の金属シリサイド電極層 113:層間絶縁膜
114:ゲート絶縁膜 115:第1の金属シリサイド膜 116, 117:第1の金属膜
118:第2のキャップ膜 119:第2の金属シリサイド膜

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体基体と、

前記半導体基体に設けられ第 1 及び第 2 の素子領域を囲む素子分離領域と、

前記第 1 の素子領域に形成されると共に、少なくともゲート電極膜におけるゲート絶縁膜に接する領域が、第 1 の金属シリサイドで構成された N チャネル電界効果トランジスタと

、
前記第 2 の素子領域に形成されると共に、ゲート電極膜が、前記第 1 の金属シリサイドを構成する金属とは異なる金属からなる第 2 の金属シリサイドと、前記第 1 の金属シリサイドの構成材料である金属及び前記第 1 の金属シリサイドと同じ構成材料であり、かつ、前記第 1 の金属シリサイドよりもシリコン含有量が少ない第 3 の金属シリサイドから選ばれた少なくとも一方とから構成された P チャネル電界効果トランジスタを有し、
前記 N チャネル電界効果トランジスタのゲート電極膜の仕事関数が、前記 P チャネル電界効果トランジスタのゲート電極膜の仕事関数よりも小さいことを特徴とする絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置。

【請求項 2】

前記 P チャネル電界効果トランジスタのゲート電極膜におけるゲート絶縁膜に接する領域が、前記第 1 の金属シリサイドを構成する金属とは異なる金属からなる第 2 の金属シリサイドと、前記第 1 の金属シリサイドの構成材料である金属及び前記第 1 の金属シリサイドと同じ構成材料であり、かつ、前記第 1 の金属シリサイドよりもシリコン含有量が少ない第 3 の金属シリサイドから選ばれた少なくとも一方とから構成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置。

【請求項 3】

前記 P チャネル電界効果トランジスタのゲート電極膜におけるゲート絶縁膜に接する領域が、前記第 1 の金属シリサイドの構成材料である金属、及び前記第 1 の金属シリサイドと同じ構成材料であり、かつ、前記第 1 の金属シリサイドよりもシリコン含有量が少ない第 3 の金属シリサイドから選ばれた少なくとも一方とから構成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置。

【請求項 4】

前記第 1 の金属シリサイドを構成するシリコンと金属の組成比として、単位体積当りの前記シリコンの原子数が、単位体積当りの前記金属の原子数の 2.5 倍以上であることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか 1 項に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置。

【請求項 5】

前記第 3 の金属シリサイドを構成するシリコンと金属の組成比として、単位体積当りの前記シリコンの原子数が、単位体積当りの前記金属の原子数以下であることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 4 のいずれか 1 項に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置。

【請求項 6】

前記第 1 の金属シリサイドはタングステンシリサイドであることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置。

【請求項 7】

前記第 2 の金属シリサイドは、白金、パラジウム並びにロジウムの金属シリサイドから選ばれた、少なくとも一種の金属シリサイドからなることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか 1 項に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置。

【請求項 8】

前記 N チャネル電界効果トランジスタ並びに前記 P チャネル電界効果トランジスタのソース及びドレイン領域上に金属膜若しくは金属シリサイド膜が形成されていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 7 のいずれか 1 項に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置。

含む半導体装置。

【請求項 9】

前記Nチャネル電界効果トランジスタのソース及びドレイン領域上に形成される前記金属膜若しくは金属シリサイド膜は、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、タンタル並びにニオブから選ばれる、少なくとも一種の金属膜若しくは金属シリサイド膜からなることを特徴とする請求項 8 に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置。

【請求項 10】

前記Pチャネル電界効果トランジスタのソース領域及びドレイン領域上に形成される前記金属膜若しくは金属シリサイド膜は、白金、パラジウム並びにロジウムから選ばれる、少なくとも一種の金属膜若しくは金属シリサイド膜からなることを特徴とする請求項 8 又は請求項 9 に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置。

【請求項 11】

前記Nチャネル電界効果トランジスタ並びに前記Pチャネル電界効果トランジスタのエクステンション領域上にエレベータッドソース領域及びエレベータッドドレイン領域として半導体膜が形成されていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 10 のいずれか 1 項に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置。

【請求項 12】

半導体基体上に素子分離領域を形成して、前記素子分離領域に囲まれるNチャネル電界効果トランジスタ領域、及び前記素子分離領域に囲まれるPチャネル電界効果トランジスタ領域を形成する工程と、

前記半導体基体上に絶縁膜を形成する工程と、

前記絶縁膜上に導電膜を形成する工程と、

前記導電膜を選択的にパターンニングしてゲート領域を形成する工程と、

パターンニングされた前記導電膜に対して自己整合的に、前記Nチャネル電界効果トランジスタ領域及び前記Pチャネル電界効果トランジスタ領域にソース及びドレイン領域を形成する工程と、

前記導電膜の周囲に側壁絶縁膜を形成する工程と、

前記ゲート領域の前記導電膜及び前記絶縁膜を除去し、前記側壁絶縁膜に囲まれる空間領域を形成する工程と、

前記空間領域に囲まれた前記Nチャネル電界効果トランジスタ領域及び前記Pチャネル電界効果トランジスタ領域上にゲート絶縁膜を形成する工程と、

前記空間領域内の前記ゲート絶縁膜上に第1の金属シリサイド膜を形成する工程と、

前記Pチャネル電界効果トランジスタ領域上に、前記第1の金属シリサイド膜を構成する金属とは異なる金属膜を形成する工程と、

前記Pチャネル電界効果トランジスタ領域の第1の金属シリサイド膜を、前記第1の金属シリサイドを構成する金属とは異なる金属からなる第2の金属シリサイド、及び前記第1の金属シリサイドの構成材料である金属並びに前記第1の金属シリサイドと同じ構成材料であり、かつ、前記第1の金属シリサイドよりもシリコン含有量が少ない第3の金属シリサイドから選ばれる少なくとも一種とで構成された膜に変換する熱処理の工程とを

有することを特徴とする絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法

【請求項 13】

前記第1の金属シリサイドとして、単位体積当りのシリコンの原子数が、単位体積当りの金属の原子数の2.5倍以上である膜を形成することを特徴とする請求項 12 に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法。

【請求項 14】

前記第3の金属シリサイドとして、単位体積当りのシリコンの原子数が、単位体積当りの金属の原子数以下である膜を形成することを特徴とする請求項 12 又は請求項 13 に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法。

【請求項 15】

前記第1の金属シリサイドとして、タングステンシリサイド膜を形成することを特徴とする請求項12乃至請求項14に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法。

【請求項16】

前記第2の金属シリサイドとして、白金、パラジウム並びにロジウムの金属シリサイドから選ばれる、少なくとも一種の金属シリサイド膜を、前記第1の金属シリサイド膜を構成する金属とは異なる金属膜を形成する工程及び前記熱処理の工程により形成することを特徴とする請求項12乃至請求項15のいずれか1項に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法。

【請求項17】

前記側壁絶縁膜を形成する工程と前記空間領域を形成する工程の間に、前記Nチャネル電界効果トランジスタ並びにPチャネル電界効果トランジスタのソース及びドレイン領域上に金属膜若しくは金属シリサイド膜を形成する工程を有することを特徴とする請求項12乃至請求項16のいずれか1項に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法。

【請求項18】

前記Nチャネル電界効果トランジスタ並びにPチャネル電界効果トランジスタのソース及びドレイン領域上に金属膜若しくは金属シリサイド膜を形成する工程は、前記熱処理の工程の後に行うことを特徴とする請求項12乃至請求項16のいずれか1項に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法。

【請求項19】

前記Pチャネル電界効果トランジスタのソース及びドレイン領域上に金属膜若しくは金属シリサイド膜を形成する工程は、前記第1の金属シリサイド膜を構成する金属とは異なる金属膜を形成する工程、及び前記熱処理の工程と共に行うことを特徴とする請求項12乃至請求項16のいずれか1項に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法。

【請求項20】

前記Nチャネル電界効果トランジスタのソース及びドレイン領域上に、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、タンタル並びにニオブから選ばれる、少なくとも一種の金属膜を、前記金属膜若しくは金属シリサイド膜を形成する工程により形成することを特徴とする請求項17乃至請求項19のいずれか1項に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法。

【請求項21】

前記Pチャネル電界効果トランジスタのソース及びドレイン領域上に、白金、パラジウム並びにロジウムから選ばれる、少なくとも一種の金属膜若しくは金属シリサイド膜を形成することを特徴とする請求項17乃至請求項20のいずれか1項に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法。

【請求項22】

前記Nチャネル電界効果トランジスタ領域及びPチャネル電界効果トランジスタのソース及びドレイン領域を形成する工程が、前記Nチャネル電界効果トランジスタ領域及び前記Pチャネル電界効果トランジスタ領域上に半導体膜を選択的に成長し、エレベータッドソース領域及びエレベータッドドレイン領域を形成する工程であることを特徴とする請求項12乃至請求項21のいずれか1項に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法。

【請求項23】

前記導電膜を選択的にパターニングしてゲート領域を形成後、前記Nチャネル電界効果トランジスタ領域及び前記Pチャネル電界効果トランジスタ領域にソース及びドレイン領域を形成する前に、パターニングされた前記導電膜をマスクとして、前記半導体基体上に形成された前記絶縁膜を更にパターニングする工程を有することを特徴とする請求項12乃至請求項22のいずれか1項に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装

10

20

30

40

50

置の製造方法。

【請求項 24】

前記導電膜の周囲に側壁絶縁膜を形成後、前記ゲート領域の前記導電膜及び前記絶縁膜を除去し、前記側壁絶縁膜に囲まれる空間領域を形成する前に、層間絶縁膜を形成する工程を有することを特徴とする請求項 12 乃至請求項 23 のいずれか 1 項に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、絶縁ゲート型電界効果トランジスタ（以下、MISFETと称す）を含む半導体装置とその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

集積回路の高性能化要求に対し、その基本回路の一つである相補型回路の高速化が図られている。これまで、相補型回路の高速化に対して、微細化技術によってその基本素子のMISFETのチャネル長を短くする方法が用いられてきた。この微細化にはMISFETを構成するゲート絶縁膜及びゲート電極膜の薄膜化も伴うため、従来用いられてきた材料では、その高速化への対応も限界に到達しつつある。このため、近年、新たな材料とそれを応用した新たな素子構造及び製造方法が開発されている。

【0003】

例えば、ゲート電極の材料として一般に用いられている多結晶シリコンは、抵抗率が高いため、これに代えて、金属あるいは金属シリサイドが用いられている。しかし、これらの材料は、多結晶シリコンに比べて耐熱性に劣るという欠点を有している。

【0004】

それに対し、高温プロセスを行った後にゲート絶縁膜及びゲート電極を形成する技術として、ダマシゲート技術がある。ダマシゲート技術では、ゲート形成予定領域に予めダミーとなる酸化膜並びに多結晶シリコン膜を形成した後、ソース及びドレイン領域を形成する。次に、そのダミーとなる膜を除去し、その除去した領域にゲート絶縁膜及び金属若しくは金属シリサイドのゲート電極を埋め込む。

【0005】

上述の方法を相補型回路で構成された集積回路に適用した場合、NチャネルMISFET及びPチャネルMISFETのゲート電極に同じ金属を用いると、ゲート電極の仕事関数は同じになるため、それぞれのしきい値電圧を回路動作上の適正な値に制御することが困難になる。従って、NチャネルMISFETとPチャネルMISFETとで、異なる金属のゲート電極材料を用いることが必要とされている。

【0006】

例えば、特許文献1では、ダミーとなる多結晶シリコン膜を形成し、ソース及びドレイン層を形成した後にそのダミー膜を除去し、その除去した領域に、NチャネルMISFETとPチャネルMISFETそれぞれ異なる材料のゲート電極を埋め込んでいる。この方法によって、NチャネルMISFET及びPチャネルMISFETのそれぞれのしきい値電圧を回路動作上の適正な値に制御し、集積回路の高性能化を図ることができる。

【0007】

【特許文献1】

特許第3264264号公報（第8頁、図4）

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

相補型回路を用いた集積回路を構成するNチャネルMISFET及びPチャネルMISFETにおいて、異なる金属のゲート電極材料を用いることは、MISFETのしきい値電圧だけでなく、ゲート絶縁膜に起因する信頼性、不純物コンタミネーションによる電流特性劣化等、集積回路の様々な性能に影響を及ぼす。

20

30

40

50

【0009】

例えば、NチャネルMISFETに第1のゲート電極材料を用い、PチャネルMISFETに第2のゲート電極材料を用いる場合を考える。この場合、半導体基板の表面全体に第1のゲート電極材料を形成した後、NチャネルMISFET形成領域の第1のゲート電極材料を残して、PチャネルMISFET形成領域の第1のゲート電極材料をエッチングによって剥離する。その後、表面処理、次の工程のための洗浄前処理等を行った後に、第2のゲート電極材料をPチャネルMISFET形成領域にのみ形成する。

【0010】

このため、第1のゲート電極材料をエッチングによって剥離する工程において、PチャネルMISFETのゲート絶縁膜は必ず、ガスあるいは薬液等のエッチング種に曝され、表面で化学反応が生ずる。また、その後の洗浄工程等においても金属コンタミネーション等を化学反応によって除去する薬液によって、同様な反応現象が引き起こされる。

【0011】

ゲート絶縁膜は、特に昨今の微細化が著しく進む中で、原子層で数えられる程度にまで薄膜化されている。従って、上述のようにガスあるいは薬液にゲート絶縁膜が曝された場合、巨視的なレベルではゲート絶縁膜のエッチングが生じないようにエッチング種を選択したとしても、微視的なレベルでのゲート絶縁膜の均一性を劣化させる問題が発生する。

【0012】

集積回路においては、製造段階でのゲート絶縁膜の電氣的絶縁特性が、長時間にわたる製品使用中に経時的に劣化することを防ぎ、信頼性を確保することが重要である。上述の不
均一性はその信頼性に悪影響とバラツキを与える要因として働くため、大きな問題となる。

【0013】

本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、しきい値電圧の制御が容易で、かつ、ゲート絶縁膜の信頼性が優れたゲート構造を備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置とその製造方法を提供することにある。

【0014】

【課題を解決するための手段】

上記の課題を解決するため、本発明による絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置は、半導体基体と、前記半導体基体に設けられ第1及び第2の素子領域を囲む素子分離領域と、前記第1の素子領域に形成されると共に、少なくともゲート電極膜におけるゲート絶縁膜に接する領域が、第1の金属シリサイドで構成されたNチャネル電界効果トランジスタと、前記第2の素子領域に形成されると共に、ゲート電極膜が、前記第1の金属シリサイドを構成する金属とは異なる金属からなる第2の金属シリサイド、及び前記第1の金属シリサイドの構成材料である金属並びに前記第1の金属シリサイドと同じ構成材料であり、かつ、前記第1の金属シリサイドよりもシリコン含有量が少ない第3の金属シリサイドから選ばれる少なくとも一種とで構成されたPチャネル電界効果トランジスタを有し、前記Nチャネル電界効果トランジスタの、前記ゲート絶縁膜に接する前記ゲート電極膜の仕事関数が、前記Pチャネル電界効果トランジスタの、前記ゲート絶縁膜に接する前記ゲート電極膜の仕事関数よりも小さいことを特徴とする。

【0015】

本発明によれば、Nチャネル電界効果トランジスタのゲート電極とPチャネル電界効果トランジスタのゲート電極に異なる金属シリサイドを用いることにより、しきい値電圧の制御が容易で、かつ、ゲート絶縁膜の信頼性が優れたゲート構造を備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置が得られる。

【0016】

また、本発明による絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法は、半導体基体上に素子分離領域を形成して、前記素子分離領域に囲まれるNチャネル電界効果トランジスタ領域、及び前記素子分離領域に囲まれるPチャネル電界効果トランジスタ領域を形成する工程と、前記半導体基体上に絶縁膜を形成する工程と、前記絶縁膜上に導

電膜を形成する工程と、前記導電膜を選択的にパターンニングしてゲート領域を形成する工程と、パターンニングされた前記導電膜に対して自己整合的に、前記Nチャネル電界効果トランジスタ領域及び前記Pチャネル電界効果トランジスタ領域にソース及びドレイン領域を形成する工程と、前記導電膜の周囲に側壁絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート領域の前記導電膜及び前記絶縁膜を除去し、前記側壁絶縁膜に囲まれる空間領域を形成する工程と、

前記空間領域に囲まれた前記Nチャネル電界効果トランジスタ領域及び前記Pチャネル電界効果トランジスタ領域上にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記空間領域内の前記ゲート絶縁膜上に第1の金属シリサイド膜を形成する工程と、前記Pチャネル電界効果トランジスタ領域上に、前記第1の金属シリサイド膜を構成する金属とは異なる金属膜を形成する工程と、前記Pチャネル電界効果トランジスタ領域の第1の金属シリサイド膜を、前記第1の金属シリサイドを構成する金属とは異なる金属からなる第2の金属シリサイド、及び前記第1の金属シリサイドの構成材料である金属並びに前記第1の金属シリサイドと同じ構成材料であり、かつ、前記第1の金属シリサイドよりもシリコン含有量が少ない第3の金属シリサイドから選ばれる少なくとも一種とで構成された膜に変換する熱処理の工程とを有することを特徴とする。

【0017】

本発明によれば、Pチャネル電界効果トランジスタ領域のゲート電極を第1の金属シリサイド膜で形成した後、その膜を剥離することなく、前記第1の金属シリサイドを構成する金属とは異なる金属からなる第2の金属シリサイドの構成材料である金属膜を前記第1の金属シリサイド膜上に形成し、熱処理を施すことにより両者の固相反応を生じさせ、前記第2の金属シリサイド、第1の金属シリサイドの構成材料である金属及び第1の金属シリサイドと同じ構成材料で、かつ、第1の金属シリサイドよりもシリコン含有量が少ない第3の金属シリサイドから選ばれる、少なくとも一種で構成される層に変換できる。このため、Nチャネル電界効果トランジスタのゲート電極よりも大きい仕事関数を備えたPチャネル電界効果トランジスタのゲート電極を、Pチャネル電界効果トランジスタのゲート絶縁膜の劣化を招くことなく形成できる。

【0018】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。

【0019】

（第1の実施の形態）

図1(a)～図4(j)は本発明による絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法の第1の実施の形態を工程順に示す断面図である。また、図4(j)は本発明による絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の第1の実施の形態を示している。本実施の形態では、NチャネルMISFET及びPチャネルMISFETの双方を形成するが、図1(a)～図2(f)の工程は、NチャネルMISFETの領域のみを代表的に示す。図3(g)以降はNチャネルMISFET及びPチャネルMISFETの双方について示す。

【0020】

先ず、図1(a)に示すように、P型のシリコン基板101の表面領域に、STI法（浅いトレンチ分離法）若しくはLOCOS法（選択酸化法）により、酸化膜を選択的に形成して、素子分離領域102とする。次に、イオン注入法でボロンイオンをドーズ量として $1E12cm^{-2} \sim 1E14cm^{-2}$ 程度注入し、その後、例えば、10秒の急速加熱を施し、導入した不純物を活性化し、P型ウェル領域101aを形成する。素子分離領域102に囲まれるP型ウェル領域101aがNチャネルMISFET領域となる。

【0021】

次に、後の工程において除去されるダミーゲート構造を形成する。即ち、熱酸化法によりシリコン酸化膜を例えば6nm成長する。次に、NチャネルMISFETのしきい値電圧を制御するためにイオン注入法でP型不純物を導入する。続いて、多結晶シリコン膜をC

VD法で例えば100 nm程度成長し、更に、シリコン窒化膜を例えば20 nm成長する。続いて、リソグラフィ法、ドライエッチング法等を用いてこれらの膜のパターニングを行い、ダミーゲート構造となる第1のキャップ膜105、導電膜104、及び絶縁膜103を形成する。次に、パターンニングされた第1のキャップ膜105、導電膜104、及び絶縁膜103をマスクとしてイオン注入法によりエクステンション領域106、107を形成する。即ち、砒素イオン若しくはリンイオンをドーズ量として $1 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2} \sim 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ 注入し、その後、例えば、数秒の急速加熱を施し、導入した不純物を活性化する。なお、絶縁膜103をパターンニングせずに、イオン注入法によりエクステンション領域106、107を形成し、その後、絶縁膜103をパターンニングしても良い。

【0022】

次に、図1 (b) に示すように、CVD法によってシリコン窒化膜を20~40 nm、シリコン基板101の全面に形成した後、RIE法によって異方性エッチングを行い、側壁絶縁膜108をダミーゲート構造に接して、その周囲に選択的に残存させる。続いて、砒素イオン若しくはリンイオンをドーズ量として $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2} \sim 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-2}$ 注入し、その後、例えば、950℃、10秒の急速加熱を施し、ソース及びドレイン領域109、110を形成する。

【0023】

更に、図示しないが、コバルト膜をスパッタ法でシリコン基板101の全面に形成した後、熱処理を行って、ソース及びドレイン領域109、110のシリコン層とのみ反応させ、コバルトシリサイド層に変換し、ソース及びドレイン領域109、110の上に第1の金属シリサイド電極層111、112を選択的に形成する。続いて、残存するコバルト膜をエッチングにより、選択的に除去する。

【0024】

次に、図1 (c) に示すように、シリコン酸化膜をCVD法でシリコン基板101全面に堆積し、その後、第1のキャップ膜105、側壁絶縁膜108の上面が露出するまでCMP法により上記絶縁膜の研磨を行い、表面を平坦化して層間絶縁膜113を選択的に残存させる。

【0025】

次に、図2 (d) に示すように、例えば磷酸を用いて、シリコン窒化膜からなる第1のキャップ膜105をシリコン酸化膜からなる層間絶縁膜113に対して選択的に除去する。更に、例えばフッ素などのハロゲン原子のラジカルを用いたエッチング技術により、多結晶シリコン膜からなる導電膜104をシリコン酸化膜からなる層間絶縁膜113及びシリコン窒化膜からなる側壁絶縁膜118に対して選択的に除去する。更に、希フッ酸等により、絶縁膜103を除去することにより、後で述べるゲート絶縁膜及びゲート電極が埋め込まれる空間領域108aを形成する。

【0026】

次に、図2 (e) に示すように、高誘電体絶縁膜であるハフニウム酸化膜113aをCVD法若しくはスパッタ法によりシリコン基板101の全面に堆積する。続いて、タンゲステンシリサイド膜113bをCVD法若しくはスパッタ法を用いて堆積する。更に、図2 (f) に示すように、CMP法を用いてシリコン基板101の表面全体を研磨して平坦化させ、空間領域108aにタンゲステンシリサイド膜113b並びにハフニウム酸化膜113aを埋め込むように残存させ、NチャネルMISFETのゲート電極となる第1の金属シリサイド膜115、及びゲート絶縁膜114とする。

【0027】

以上により、NチャネルMISFETが形成される。PチャネルMISFETについてもNチャネルMISFETと同じ製造手順でウェル領域、エクステンション領域、並びにソース及びドレイン領域の製造工程について、適切な条件を選ぶことによって形成できる。即ち、導入される不純物の導電型をNチャネルMISFETとは異なるものとし、不純物導入に際してはNチャネルMISFET側をマスクで覆っておく。図3及び図4では以降の工程について、NチャネルMISFET及びPチャネルMISFETを合わせて図示し

10

20

30

40

50

、PチャネルMISFETの電極を形成する工程を示す。

【0028】

まず、図3 (g) に示すように、NチャネルMISFETのゲート電極を構成している第1の金属シリサイド膜115並びにゲート絶縁膜114の反応を防ぐため、チタン窒化膜をスパッタ法などでシリコン基板101全面に堆積した後、リソグラフィ技術とエッチング技術を用いてNチャネルMISFET形成領域にのみ、チタン窒化膜が残存するように選択的に加工し、バリア金属膜116とする。

【0029】

次に、図3 (h) に示すように、白金膜を例えばスパッタ法等でシリコン基板101上に堆積し、PチャネルMISFETのゲート電極の構成材料となる第1の金属膜117とする。更に、チタン窒化膜をスパッタ法等で堆積し、第2のキャップ膜118とする。その後、熱処理を行うと、PチャネルMISFETの第1の金属シリサイド膜115上に形成された第1の金属膜117が第1の金属シリサイド膜115と固相反応を起す。

【0030】

即ち、基本的な反応としてタングステンシリサイドはタングステンとシリコンに分解し、タングstenは析出し、シリコンは白金と結合して白金シリサイドを形成する。即ち、図3 (i) に示すように、白金シリサイドが第2の金属シリサイド膜119としてPチャネルMISFETのゲート電極になる。但し、第2の金属シリサイド膜119にはタングstenも含まれており、この固相反応におけるタングstenの挙動は、タングstenシリサイド中のシリコン組成比、あるいは熱処理条件等により変化し、タングstenの存在形態等も、それに伴って変化する。これに関しては後で述べる。

【0031】

一方、NチャネルMISFETのゲート電極では、第1の金属膜117の下に形成したバリア金属膜116が、第1の金属膜117の構成原子による第1の金属シリサイド膜114への拡散及び反応を抑制するため、第1の金属シリサイド膜115はそのままの状態に残存する。

【0032】

次に、図4 (j) に示すように、CMP技術、エッチング技術等により第2のキャップ膜118、未反応の第1の金属膜117、バリア金属膜116を除去し、表面の平坦化を行う。

【0033】

その後、図示しないSiO₂等の層間絶縁膜をシリコン基板101全面に堆積する。この層間絶縁膜にコンタクト孔を開口し、NチャネルMISFETのゲート電極である第1の金属シリサイド膜115、PチャネルMISFETのゲート電極である第2の金属シリサイド膜119、ソース及びドレインの電極層である第1の金属シリサイド電極層111、112にAl、Cu等の金属配線を形成する。さらに、必要に応じて層間絶縁膜の堆積と、金属配線の形成を繰り返して多層配線構造を形成したうえで、シリコン基板101全面を表面保護膜で覆い、パッド部を開口して本発明によるMISFETを含む半導体装置の第1の実施の形態を完成させる。

【0034】

次に、先に述べたPチャネルMISFETのゲート電極になる第2の金属シリサイド膜119の構造について図5を用いて説明する。第2の金属シリサイド膜119の構造は白金シリサイド膜が主体となり、タングstenの存在形態はタングstenシリサイド膜及び白金膜の厚さ、タングstenシリサイド膜中のシリコンとタングstenの組成比、反応時の熱処理の条件等により異なってくる。

【0035】

まず、第1の構造例を図5 (a) に示す。この構造例では、第2の金属シリサイド膜119において、ゲート絶縁膜114に接する部分にタングsten析出層121が形成されており、また、白金シリサイド層120にはタングsten粒子122が存在する。なお、タングsten析出層121及びタングsten粒子122にはシリコンが含まれている場合も

あり、また、その結晶構造としてタングステンシリサイドが含まれている場合もある。但し、そのタングステンシリサイドはNチャネルMISFETのゲート電極を構成する、第1の金属シリサイドとしてのタングステンシリサイドからシリコンが析出した後のものであるため、第1の金属シリサイドよりもシリコン含有量が少ない。即ち、タングステンシリサイドとして、第1の金属シリサイドとはシリコン含有量が異なる、第3の金属シリサイドの形態をとる。なお、このような第3の金属シリサイドが含まれる場合もあることは以下の第2の構造例乃至第4の構造例についても同じである。

【0036】

次に、第2の金属シリサイド膜119の第2の構造例を図5(b)に示す。タングステン析出層121はゲート絶縁膜114全面を覆っておらず、一部は白金シリサイド層120がゲート絶縁膜114に接している。次に、第2の金属シリサイド膜119の第3の構造例を図5(c)に示す。ゲート絶縁膜114の界面付近ではタングステン析出層がほとんど粒子化しており、ゲート絶縁膜114と接している領域は白金シリサイド層120がほとんどである。

【0037】

次に、第2の金属シリサイド膜119について第4の構造例を図5(d)に示す。この構造例は、上述した第1乃至第3の構造例を実現する条件よりも、タングステンシリサイドの膜厚が薄い場合に起きる。即ち、ゲート絶縁膜114に接する部分にタングステンが析出するほどタングステンの量が多くない場合である。従って、ゲート絶縁膜114と接する部分はすべて白金シリサイド膜120によって覆われている。なお、図示しないが、白金シリサイド層120中にタングステンがほとんど析出しない場合もあることは勿論である。

【0038】

図5(a)乃至(d)のいずれの構造例においても、ゲート電極の仕事関数が決定されるゲート絶縁膜114と接する厚さ1nm程度の領域は、白金シリサイド、タングステン並びに第1の金属シリサイドであるタングステンシリサイドよりもシリコン含有量が少ない第3の金属シリサイドのうち、少なくとも一種から構成される。白金シリサイド及びタングステンの仕事関数は共に4.8~4.9eV程度のため、PチャネルMISFETのゲート電極として適切な値になる。一方、NチャネルMISFETのゲート電極はタングステンシリサイドであり、その仕事関数は4.3~4.6eV程度のため、NチャネルMISFETのゲート電極として適切な値になる。

【0039】

また、タングステンシリサイドはシリコン含有量が少ない程、その仕事関数は大きくなるため、PチャネルMISFETのゲート電極に第3の金属シリサイドが含まれていた場合においても、本実施の形態ではPチャネルMISFETのゲート電極の仕事関数はNチャネルMISFETのゲート電極の仕事関数より大きな値をもつ。このため、集積回路を構成する相補型回路として本実施の形態で示したゲート電極は最適な構造になる。

【0040】

さらに、上述の理由から、NチャネルMISFETのゲート電極である第1の金属シリサイド膜115としては、シリコンの組成比が2よりも大きく、2.5以上が望ましい。また、PチャネルMISFETのゲート電極である第3の金属シリサイド膜のシリコン組成比は、タングステン組成比よりも小さいことが望ましい。更に、第1の金属シリサイドを構成する金属としてタングステン以外にも、モリブデン、チタン、ジルコニウム、ハフニウム、タンタル並びにニオブ等がある。一方、第2の金属シリサイドを構成する金属としては白金以外に、パラジウム及びロジウムがある。

【0041】

本実施の形態によれば、PチャネルMISFETにおいて、ゲート絶縁膜表面をエッチングガスや薬液等に曝さずに、NチャネルMISFETのゲート電極とは異なる材料で構成されたゲート電極を形成できる。このため、NチャネルMISFETのゲート電極及びPチャネルMISFETのゲート電極が共に適切な仕事関数を持ち、しきい値電圧の制御が

容易で、かつ、ゲート絶縁膜の信頼性が優れたゲート構造を備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置とその製造方法が得られる。

【0042】

(第2の実施の形態)

本発明による絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法の第2の実施の形態を図6を用いて説明する。工程の開始から第1の金属シリサイドをダミーゲート構造の空間部に埋め込むまでは、図1(a)乃至図2(f)に示す第1の実施の形態と同様の工程である。従って、図2(f)以降の工程を図6(a)乃至(c)に示す断面図を用いて順次説明する。又、図6(c)は本発明による絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の第2の実施の形態を示している。

10

【0043】

図6では左側にNチャネルMISFET領域、右側にPチャネルMISFET領域を図示している。NチャネルMISFETのゲート電極を構成している第1の金属シリサイド膜115並びにゲート絶縁膜114の反応を防ぐため、図6(a)に示すように、シリコン基板101の全面にシリコン窒化膜をCVD法若しくはスパッタ法等で堆積した後、リソグラフィ技術とエッチング技術等を用いて選択的にパターニングを行って、NチャネルMISFET領域にのみ、第1のバリア絶縁膜123を残存させる。第1の実施の形態ではチタン窒化膜を用いたが、本実施の形態では酸素雰囲気中で熱処理を行っても酸化されない材料として、例えばシリコン窒化膜を用いている。

【0044】

20

次に、白金膜をスパッタ法等で堆積し、PチャネルMISFETのゲート電極の構成材料となる第1の金属膜117とする。更に、チタン窒化膜をスパッタ法等で堆積し、第2のキャップ膜118とする。その後、熱処理を行うと、図6(b)に示すように、PチャネルMISFETのゲート電極上に形成された第1の金属膜117がその下の第1の金属シリサイド膜115と固相反応を起し、PチャネルMISFETのゲート電極は第2の金属シリサイド膜119になる。

【0045】

次に、第2のキャップ膜118を薬液で選択的に除去する。続いて、500℃程度で酸化雰囲気中の熱処理を行うと、未反応の白金である第1の金属膜117は酸化されず、その下面にある白金シリサイド中のシリコン原子が表面に移動し、優先的に酸化され、シリコン酸化膜がPチャネルMISFETのゲート電極上面に形成される。このシリコン酸化膜を第2のバリア絶縁膜124とする。続いて、図6(c)に示すように、第2のバリア絶縁膜124をマスクとして、王水などで未反応の第1の金属膜117を選択的に除去する。更に、リン酸などで第1のバリア絶縁膜123も除去する。

30

【0046】

その後、図示してないSiO₂等の層間絶縁膜をシリコン基板全面に堆積する。この層間絶縁膜にコンタクト孔を開口し、NチャネルMISFETのゲートゲート電極である第1の金属シリサイド膜115、PチャネルMISFETのゲート電極である第2の金属シリサイド膜119、ソース及びドレインの電極層である第1の金属シリサイド電極層111、112にAl、Cu等の金属配線を形成する。さらに、必要に応じて層間絶縁膜の堆積と、金属配線の形成を繰り返して多層配線構造を形成したうえで、シリコン基板全面を表面保護膜で覆い、パッド部を開口して本発明によるMISFETを含む半導体装置の第2の実施の形態を完成させる。

40

【0047】

本実施の形態によれば、PチャネルMISFETにおいて、ゲート絶縁膜表面をエッチングガスや薬液等に曝さずに、NチャネルMISFETのゲート電極とは異なる材料で構成されたゲート電極を形成できる。このため、NチャネルMISFETのゲート電極及びPチャネルMISFETのゲート電極が共に適切な仕事関数をもつ、しきい値電圧の制御が容易で、かつ、ゲート絶縁膜の信頼性が優れたゲート構造を備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置とその製造方法が得られる。

50

【0048】

又、バリア絶縁膜であるシリコン酸化膜をマスクとして用いることにより、未反応の白金並びにバリア絶縁膜を除去できる。このため、P型MISFETのゲート電極に損傷を与えることなく、MISFETが形成可能になる。

【0049】

(第3の実施の形態)

図7(a)乃至図10(k)は本発明による絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法の第3の実施の形態を工程順に示す断面図である。また、図10(k)は本発明による絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の第3の実施の形態を示している。本発明では、NチャネルMISFET及びPチャネルMISFETの双方を形成するが、図7(a)乃至図8(e)の工程は、NチャネルMISFETの領域のみを代表的に示す。図9(f)以降はNチャネルMISFET及びPチャネルMISFETの双方について示す。本実施の形態による製造方法は、ゲート絶縁膜、ゲート電極の成膜を行った後に、ソース及びドレイン領域上面に金属シリサイド電極層を形成することに特徴を有する。

【0050】

まず、図7(a)に示すように、半導体基体としてP型のシリコン基板201の表面領域に、STI法(浅いトレンチ分離法)若しくはLOCOS法(選択酸化法)により、酸化膜を選択的に形成して、素子分離領域202とする。次に、イオン注入法でボロンイオンをドーズ量として $1E12\text{ cm}^{-2} \sim 1E14\text{ cm}^{-2}$ 程度注入し、その後、例えば、10秒の急速加熱を施し、導入した不純物を活性化し、P型ウェル領域201aを形成する。素子分離領域202に囲まれるP型ウェル領域201aがNチャネルMISFET領域となる。

【0051】

次に、後の工程において除去されるダミーゲート構造を形成する。即ち、熱酸化法によりシリコン酸化膜を例えば8nm成長する。次に、NチャネルMISFETのしきい値電圧を制御するためにイオン注入法でP型不純物を導入する。続いて、多結晶シリコン膜をCVD法で例えば200nm程度堆積する、更に、リソグラフィ法、ドライエッチング法等を用いてこれらの膜のパターニングを行い、ダミーゲート構造として導電膜204、及び絶縁膜203を形成する。次に、パターニングされた導電膜204、及び絶縁膜203をマスクとしてイオン注入法により不純物を導入し、エクステンション領域205、206を形成する。即ち、砒素イオンもしくはリンイオンをドーズ量として $1E13\text{ cm}^{-2} \sim 5E15\text{ cm}^{-2}$ 程度注入し、その後、例えば、900℃、5秒の急速加熱を施し、導入した不純物を活性化する。

【0052】

次に、図7(b)に示すように、CVD法によってシリコン窒化膜を30nm程度シリコン基板201全面に形成した後、RIE法によって異方性エッチングを行い、ダミーゲート構造に接して、その周囲に側壁絶縁膜207を選択的に残存させる。再度、砒素イオン若しくは、リンイオンをドーズ量として $1E15\text{ cm}^{-2} \sim 1E16\text{ cm}^{-2}$ 程度注入し、その後、例えば、900℃、10秒の急速加熱を施し、ソース及びドレイン領域208、209を形成する。続いて、図7(c)に示すように、シリコン窒化膜を例えば10nm程度シリコン基板表面201に全面に堆積し、第3のキャップ膜210とする。

【0053】

次に、図8(d)に示すように、例えばシリコン酸化膜をCVD法により堆積し、更に、CMP技術を用いて第3のキャップ膜210の上面が露出するまで平坦化を行い、埋め込み絶縁膜211とする。続いて、第3のキャップ膜210の一部である、導電膜204の上にあるシリコン窒化膜を選択的に除去する。

【0054】

次に、図8(e)に示すように、例えばフッ素などのハロゲン原子のラジカルを用いたエッチング技術により、導電膜204を埋め込み絶縁膜211及び側壁絶縁膜207対して

選択的に除去する。次に、希フッ酸等により絶縁膜103を除去することにより、後で述べるゲート絶縁膜及びゲート電極が埋め込まれる空間領域212を形成する。

【0055】

以上のように、ゲート絶縁膜及びゲート電極を除くNチャネルMISFETが形成される。PチャネルMISFETについてもNチャネルMISFETと同じ製造手順でウェル領域、エクステンション領域、並びにソース及びドレイン領域の製造工程について、適切な条件を選ぶことによって形成できる。即ち、導入される不純物の導電型をNチャネルMISFETとは異なるものとし、不純物導入に際してはNチャネルMISFET側をマスクで覆っておく。

【0056】

10

図9及び図10は上述のようにして形成されたNチャネル及びPチャネルMISFET領域を示しており、左側にNチャネルMISFET領域、右側にPチャネルMISFET領域を図示する。まず、図9(f)に示すように、高誘電体絶縁膜であるハフニウム酸化膜をCVD法、或いはスパッタ法によりシリコン基板201の全面に堆積する。次に、タングステンシリサイドをCVD法もしくはスパッタ法を用いて成長し、更に、CMP法を用いてシリコン基板表面全体を研磨することにより、埋め込み絶縁膜211が露出するように平坦化し、ゲート絶縁膜213、NチャネルMISFETのゲート電極となる第1の金属シリサイド膜214とする。

【0057】

次に、図9(g)に示すように、第1の金属シリサイド膜214並びにゲート絶縁膜213の反応を防ぐため、チタン窒化膜をスパッタ法などでシリコン基板201の全面に成膜した後、リソグラフィ技術とエッチング技術を用いてNチャネルMISFET領域にのみ残存するように、選択的にパターニングし、バリア金属膜215とする。次に、白金膜をスパッタ法等で堆積し、PチャネルMISFETのゲート電極の構成材料となる第1の金属膜216とする。更に、チタン窒化膜をスパッタ法等で堆積し、第2のキャップ膜217とする。

【0058】

その後、熱処理を行うと、図9(c)に示すように、PチャネルMISFETゲート電極領域の第1の金属シリサイド膜214とその上に形成された第1の金属膜216の固相反応が生じる。この結果、第2の金属シリサイド膜218がPチャネルMISFETのゲート電極として形成される。次に、CMP技術、エッチング技術等により第2のキャップ膜217、未反応の白金である第1の金属膜216、バリア金属膜215を除去すると共に、表面の平坦化を行う。

【0059】

次に、図10(i)に示すように、弗酸などの薬液若しくはドライエッチングで、埋め込み絶縁膜211を選択的に除去する。更にRIE法等のドライエッチング技術を用いてシリコン窒化膜である第3のキャップ膜210を異方性エッチングして、側壁絶縁膜207の側壁に残存させ、ソース及びドレイン領域208、209の上面を露出させる。

【0060】

更に、ニッケルをスパッタ法等によってシリコン基板201全面に堆積し、第2の金属膜219を形成し、その後、図10(j)に示すように、500℃程度で熱処理を行い、ソース及びドレイン領域208、209上にのみニッケルシリサイドを成長させ、第2の金属シリサイド電極層220、221とする。続いて、未反応の第2の金属膜219を薬液により除去する。

【0061】

その後、図示しないSiO₂等の層間絶縁膜をシリコン基板201全面に堆積する。この層間絶縁膜にコンタクト孔を開口し、NチャネルMISFETのゲートゲート電極である第1の金属シリサイド膜214、PチャネルMISFETのゲート電極である第2の金属シリサイド膜218、ソース及びドレイン領域の電極である第2の金属シリサイド電極層220、221にAl、Cu等の金属配線を形成する。さらに、必要に応じて層間絶縁膜

50

の堆積と、金属配線の形成を繰り返して多層配線構造を形成したうえで、シリコン基板 201 全面を表面保護膜で覆い、パッド部を開口して本発明による M I S F E T を含む半導体装置の第 3 の実施の形態を完成させる。

【0062】

本実施の形態によれば、Pチャネル M I S F E T において、ゲート絶縁膜表面をエッチングガスや薬液等に曝さずに、Nチャネル M I S F E T のゲート電極とは異なる材料で構成されたゲート電極を形成できる。このため、Nチャネル M I S F E T のゲート電極及び Pチャネル M I S F E T のゲート電極が共に適切な仕事関数をもつ、しきい値電圧の制御が容易で、かつ、ゲート絶縁膜の信頼性が優れたゲート構造を備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置とその製造方法が得られる。

10

【0063】

又、ゲート絶縁膜及びゲート電極膜を含めたゲート電極構造を形成する比較的高温の熱処理工程の後に、ソース及びドレイン領域にシリサイド電極層を形成できる。ニッケルはコバルト、チタン等と比較すると、より低温でシリコンと反応してシリサイドを形成するため、本実施の形態に比較的適している。又、ニッケルシリサイドは比較的低抵抗のため、素子的高速動作に対して優れた材料である。

【0064】

(第 4 の実施の形態)

図 11 (a) ~ 図 13 (i) は本発明による絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法の第 4 の実施の形態を工程順に示す断面図である。また、図 13 (i) は本発明による絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の第 4 の実施の形態を示している。本発明では、Nチャネル M I S F E T 及び Pチャネル M I S F E T の双方を形成するが、図 11 (a) 乃至図 11 (c) の工程は、Nチャネル M I S F E T の領域のみを代表的に示す。図 12 (a) 以降は Nチャネル M I S F E T 及び Pチャネル M I S F E T の双方について示す。本実施の形態では、ソース及びドレイン領域として、シリコン膜をシリコン基板表面に選択的に成長し、エレベーターソース及びエレベータードレイン領域を形成している。

20

【0065】

先ず、図 11 (a) に示すように、半導体基体として P 型のシリコン基板 301 の表面領域に、S T I 法 (浅いトレンチ分離法) もしくは L O C O S 法 (選択酸化法) により、酸化膜を選択的に形成して、素子分離領域 302 とする。次に、イオン注入法でボロンイオンをドーズ量として $1 \text{ E } 12 \text{ cm}^{-2} \sim 1 \text{ E } 14 \text{ cm}^{-2}$ 程度注入し、その後、例えば、10 秒の急速加熱を施し、導入した不純物を活性化し、P 型ウェル領域 301 a を形成する。素子分離領域 302 に囲まれる P 型ウェル領域 301 a が Nチャネル M I S F E T 領域となる。

30

【0066】

次に、後の工程において除去されるダミーゲート構造を形成する。即ち、熱酸化法によりシリコン酸化膜を例えば 6 nm 成長する。次に、Nチャネル M I S F E T のしきい値電圧を制御するためにイオン注入法で P 型不純物を導入する。続いて、多結晶シリコン膜を C V D 法で例えば 100 nm 程度成長し、更に、シリコン窒化膜を例えば 20 nm 成長する。続いて、リソグラフィ法、ドライエッチング法等を用いてこれらの膜のパターニングを行い、ダミーゲート構造となる第 1 のキャップ膜 305、導電膜 304、及び絶縁膜 303 を形成する。次に、パターニングされた第 1 のキャップ膜 305、導電膜 304、及び絶縁膜 303 をマスクとしてイオン注入法によりエクステンション領域 306、307 を形成する。即ち、砒素イオン若しくはリンイオンをドーズ量として $1 \text{ E } 13 \text{ cm}^{-2} \sim 5 \text{ E } 15 \text{ cm}^{-2}$ 注入し、その後、例えば、数秒の急速加熱を施し、導入した不純物を活性化する。

40

【0067】

次に、図 11 (b) に示すように、C V D 法によってシリコン窒化膜を 20 ~ 40 nm、シリコン基板 301 全面に形成した後、R I E 法によって異方性エッチングを行い、シリ

50

コン窒化膜からなる側壁絶縁膜308をダミーゲート構造に接して、その周囲に残存させる。更に、エクステンション領域306、307上に選択的にシリコンを50nm程度成長させて、エレベータッドソース及びエレベータッドドレイン領域309、310とする。

【0068】

次に、砒素イオンもしくはリンイオンをドーズ量として $1E15cm^{-2} \sim 1E16cm^{-2}$ 程度注入し、その後、例えば、950℃、10秒の急速加熱を施し、エレベータッドソース及びエレベータッドドレイン領域に不純物を導入する。また、エクステンション領域を本工程のエレベータッドソース及びエレベータッドドレイン領域309、310を形成する時に不純物の固相拡散により同時に形成しても何ら問題無い。更に、シリコン酸化膜をCVD法でシリコン基板301前面に堆積し、更に、CMP技術によりキャップ膜305の上面が露出するまで平坦化し、層間絶縁膜311とする。

【0069】

次に、図11(c)に示すように、例えば燐酸を用いて、第1のキャップ膜305をエッチングにより層間絶縁膜311に対して選択的に除去する。更に、例えばフッ素などのハロゲン原子のラジカルを用いたエッチング技術により、導電膜304を、共にシリコン窒化膜である層間絶縁膜311及び側壁絶縁膜308に対して選択的に除去する。次に、希フッ酸等の薬液により絶縁膜303を除去することにより、後で述べるゲート絶縁膜及びゲート電極が埋め込まれる空間領域308aを形成する。

【0070】

以上のように、ゲート絶縁膜及びゲート電極を除くNチャネルMISFETが形成される。PチャネルMISFETについてもNチャネルMISFETと同じ製造手順でウェル領域、エクステンション領域、並びにソース及びドレイン領域の製造工程について、適切な条件を選ぶことによって形成できる。即ち、導入される不純物の導電型をNチャネルMISFETとは異なるものとし、不純物導入に際してはNチャネルMISFET側をマスクで覆っておく。

【0071】

図12及び図13は上述のようにして形成されたNチャネル及びPチャネルMISFET領域を示しており、左側にNチャネルMISFET領域、右側にPチャネルMISFET領域を図示する。先ず、図12(d)に示すように、高誘電体絶縁膜であるハフニウム酸窒化膜をCVD法、或いはスパッタ法によりシリコン基板301全面に堆積する。

【0072】

次に、タンゲステンシリサイドをCVD法若しくはスパッタ法を用いて成長させ、更に、CMP法を用いて層間絶縁膜311並びにエレベータッドソース及びエレベータッドドレイン領域309、310のシリコン膜上面が露出するまで研磨して平坦化する。

【0073】

次に、図12(e)に示すように、白金膜をスパッタ法等で堆積し、更に、チタン窒化膜をスパッタ法等で堆積した後、リソグラフィ技術とエッチング技術を用いてPチャネルMISFET領域上にだけ、選択的にPチャネルMISFETのゲート電極の構成材料となる第1の金属膜314及び第4のキャップ膜315を残存させる。

【0074】

その後、500℃程度で熱処理を行うと、図12(f)に示すように、PチャネルMISFETの第1の金属シリサイド膜313と、その上に形成された第1の金属膜314が固相反応を起し、第2の金属シリサイド膜316がPチャネルMISFETのゲート電極として形成される。また、PチャネルMISFET領域のエレベータッドソース及びエレベータッドドレイン領域309、310においては白金シリサイド膜が成長し、第3の金属シリサイド電極層317、318が形成される。次に、第4のキャップ膜315を硫酸と過酸化水素水の混合液などで選択的に除去し、続いて、王水などで未反応の第1の金属膜314を選択的に除去する。

【0075】

次に、図13 (g) に示すように、シリコン基板全面にチタンをスパッタ法などで堆積した後、リソグラフィ技術とドライエッチング技術等で、NチャネルMISFET領域にのみチタンが残存するように選択的に加工し、第3の金属膜319とする。更に、500℃程度で熱処理を行う。これによって、図13 (e) に示すように、NチャネルMISFET領域におけるエレベータードソース及びエレベータードドレイン領域309、310の上のチタンがシリサイド化し、第4の金属シリサイド電極層320、321を形成する。

【0076】

次に薬液により未反応の第3の金属膜319を選択的に除去する。以上により、NチャネルMISFETのソース及びドレイン領域上にはチタンシリサイドが形成され、PチャネルMISFETのソース及びドレイン領域上には白金シリサイドが形成される。

10

【0077】

その後、図示しないSiO₂等の層間絶縁膜をシリコン基板301の全面に堆積する。この層間絶縁膜にコンタクト孔を開口し、NチャネルMISFETのゲート電極である第1の金属シリサイド膜313、PチャネルMISFETの第2のゲート電極である金属シリサイド膜316、エレベータードソース及びエレベータードドレイン領域309、310の電極である第3の金属シリサイド電極層317、318、第4の金属シリサイド電極層320、321にそれぞれAl、Cu等の金属配線を形成する。さらに、必要に応じて層間絶縁膜の堆積と、金属配線の形成を繰り返して多層配線構造を形成したうえで、シリコン基板301の全面を表面保護膜で覆い、パッド部を開口して本発明によるMISFETを含む半導体装置の第4の実施の形態を完成させる。

20

【0078】

本実施の形態によれば、PチャネルMISFETにおいて、ゲート絶縁膜表面をエッチングガスや薬液等に曝さずに、NチャネルMISFETのゲート電極とは異なる材料で構成されたゲート電極を形成できる。このため、NチャネルMISFETのゲート電極及びPチャネルMISFETのゲート電極が共に適切な仕事関数をもつ、しきい値電圧の制御が容易で、かつ、ゲート絶縁膜の信頼性が優れたゲート構造を備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置とその製造方法が得られる。

【0079】

また、NチャネルMISFET及びPチャネルMISFETのエレベータードソース及びエレベータードドレイン領域に金属シリサイド電極を形成することにより、MISFETの更なる微細化に対応可能な構造を形成できる。

30

【0080】

なお、本実施の形態では、エレベータードソース領域及びエレベータードドレイン領域に金属シリサイドを形成する際、NチャネルMISFET領域とPチャネルMISFET領域とを別々に行ったが、以下の方法を用いることによって同時に行うことも可能である。即ち、第1の金属膜314と第4のキャップ膜315をP型MISFET領域に形成した後、熱処理を行わずに、第3の金属膜319を形成する。その後に熱処理を行うことによって、N型MISFET領域とP型MISFET領域とに同時に所望の金属シリサイドを形成できる。

【0081】

また、PチャネルMISFET領域のエレベータードソース及びエレベータードドレイン領域に白金シリサイド膜を形成後、酸化雰囲気での熱処理を行って、金属シリサイド膜並びにシリコン膜表面上にシリコン酸化膜を形成し、金属シリサイドが他の金属もしくは金属シリサイドと反応し難くすることも可能である。

40

【0082】

なお、本発明は上述した各実施形態に何ら限定されるものではなく、基板材料は他の半導体やSOI構造を持つ基板でも良く、また、ゲート絶縁膜としてはハフニウム酸化膜以外にSiO₂、SiO_xN_y、SiN_x、金属酸化物、金属シリケート、およびそれらの組み合わせであってもよい。更に、他の絶縁膜、金属シリサイド、導入不純物等を変更しても良く、本発明の主旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施することができる。

50

【0083】

【発明の効果】

以上、詳述したように、本発明によれば、しきい値電圧の制御が容易で、かつ、ゲート絶縁膜の信頼性が優れたゲート構造を備えたMISFETを含む半導体装置とその製造方法が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による半導体装置の製造方法の第1の実施の形態を工程順に示す断面図。

【図2】本発明による半導体装置の製造方法の第1の実施の形態を工程順に示す断面図。

【図3】本発明による半導体装置の製造方法の第1の実施の形態を工程順に示す断面図。

【図4】本発明による半導体装置の製造方法の第1の実施の形態を工程順に示す断面図。

【図5】本発明による半導体装置の製造方法の第1の実施の形態における、PチャネルMISFETの種々のゲート電極構造を示す断面図。 10

【図6】本発明による半導体装置の製造方法の第2の実施の形態を工程順に示す断面図。

【図7】本発明による半導体装置の製造方法の第3の実施の形態を工程順に示す断面図。

【図8】本発明による半導体装置の製造方法の第3の実施の形態を工程順に示す断面図。

【図9】本発明による半導体装置の製造方法の第3の実施の形態を工程順に示す断面図。

【図10】本発明による半導体装置の製造方法の第3の実施の形態を工程順に示す断面図。

。【図11】本発明による半導体装置の製造方法の第4の実施の形態を工程順に示す断面図。

。【図12】本発明による半導体装置の製造方法の第4の実施の形態を工程順に示す断面図。 20

。【図13】本発明による半導体装置の製造方法の第4の実施の形態を工程順に示す断面図。

。【符号の説明】

101、201、301 シリコン基板

101a、201a、301a P型ウェル領域

101b、201b、301b N型ウェル領域

102、202、302 素子分離領域

103、203、303 絶縁膜

104、204、304 導電膜

105、305 第1のキャップ膜

106、107、205、206、306、307 エクステンション領域

108、207、308 側壁絶縁膜

109、110、208、209 ソース及びドレイン領域

111、112 第1の金属シリサイド電極層

113、311 層間絶縁膜

108a、212、308a 空間領域

113a ハフニウム酸化膜

113b タングステンシリサイド膜

114、213、312 ゲート絶縁膜

115、214、313 第1の金属シリサイド膜

116、215 バリヤ金属膜

117、216、314 第1の金属膜

118、217 第2のキャップ膜

119、218、316 第2の金属シリサイド膜

120 白金シリサイド層

121 タングステン析出層

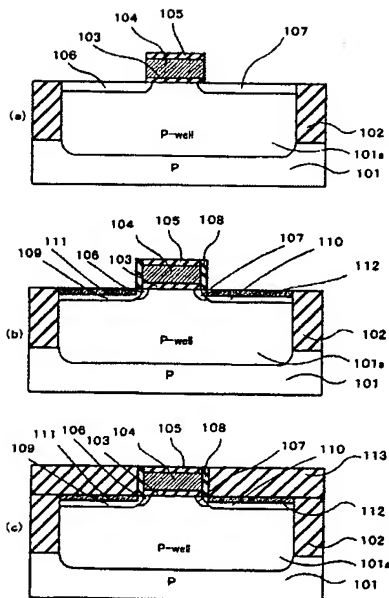
122 タングステン粒子

123 第1のバリヤ絶縁膜

- 124 第2のバリア絶縁膜
 210 第3のキャップ膜
 211 埋め込み絶縁膜
 219 第2の金属膜
 220、221 第2の金属シリサイド電極層
 309、310 エレベテッドソース及びエレベテッドドレイン領域
 315 第4のキャップ膜
 317、318 第3の金属シリサイド電極層
 319 第3の金属膜
 320、321 第4の金属シリサイド電極層

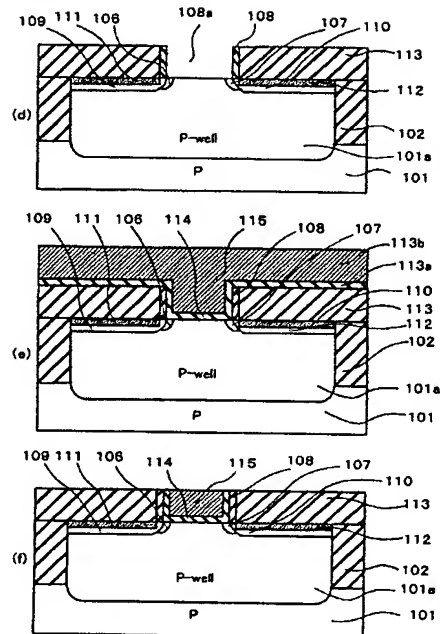
10

【図1】



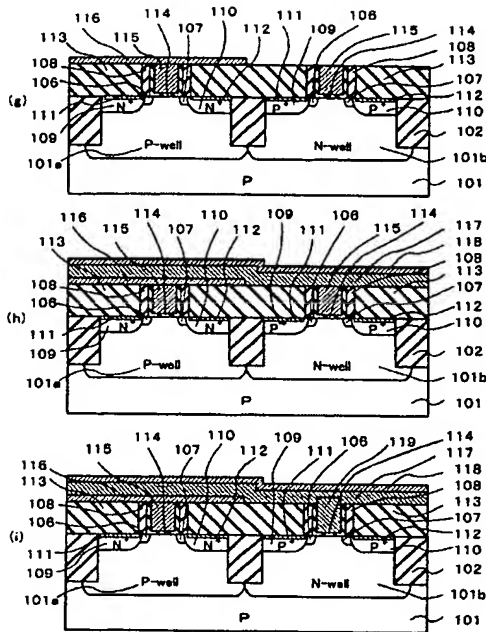
101:シリコン基板 101a:P型ウェル領域 102:素子分離領域
 103:絶縁膜 104:電極膜 105:第1のキャップ膜
 106、107:エクステンション領域 108:側壁絶縁膜
 109、110:ソース及びドレイン領域 111、112:第1の金属シリサイド電極層
 113:層間絶縁膜

【図2】



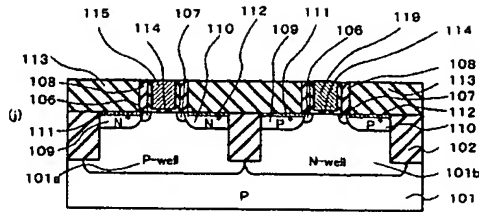
101:シリコン基板 101a:P型ウェル領域 102:素子分離領域
 106、107:エクステンション領域 108:側壁絶縁膜 108a:空間領域
 109、110:ソース及びドレイン領域
 111、112:第1の金属シリサイド電極層 113:層間絶縁膜
 113a:ハフニウム酸化物膜 113b:タンタムシリサイド膜
 114:ゲート絶縁膜 115:第1の金属シリサイド膜

【図3】



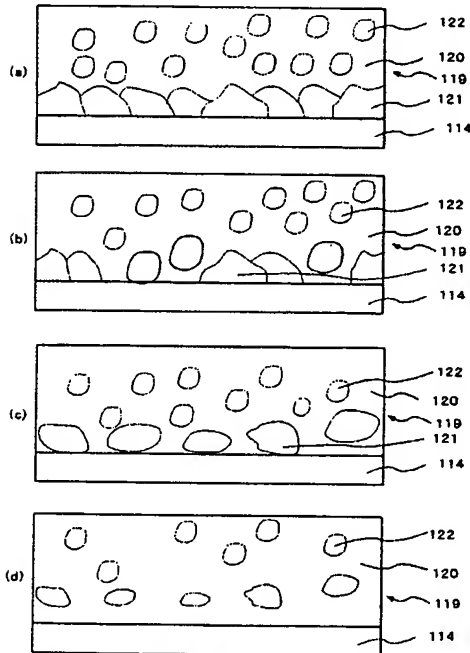
101:シリコン基板 101a:P型ウェル領域 101b:N型ウェル領域
 102:素子分離領域 106, 107:エクステンション領域 108:側壁絶縁膜
 109, 110:ソース及びドレイン領域 111, 112:第1の金属シリサイド電極層 113:層間絶縁膜
 114:ゲート絶縁膜 115:第1の金属シリサイド膜 116:バリア金属膜
 117:第1の金属膜 118:第2のキャップ膜 119:第2の金属シリサイド膜

【図4】



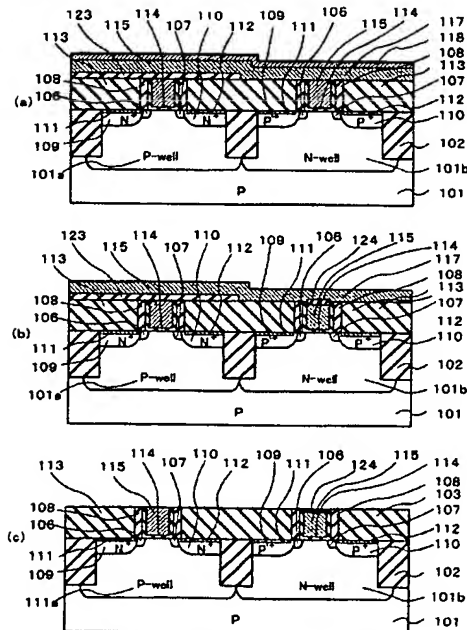
101:シリコン基板 101a:P型ウェル領域 101b:N型ウェル領域
 102:素子分離領域 106, 107:エクステンション領域 108:側壁絶縁膜
 109, 110:ソース及びドレイン領域 111, 112:第1の金属シリサイド電極層 113:層間絶縁膜
 114:ゲート絶縁膜 115:第1の金属シリサイド膜 116:バリア金属膜
 117:第1の金属膜 118:第2のキャップ膜 119:第2の金属シリサイド膜

【図5】



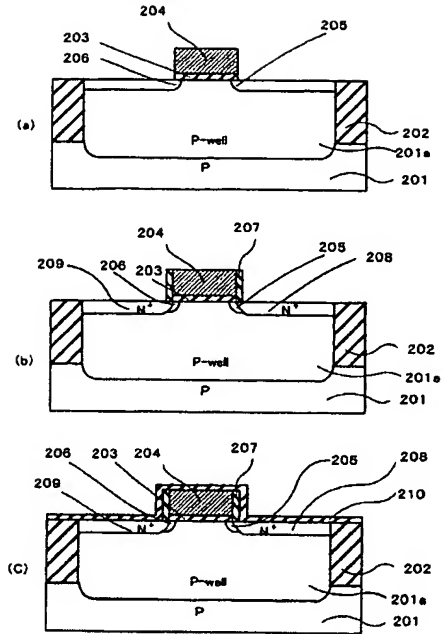
114:ゲート絶縁膜 119:第2の金属シリサイド膜
 120:白金シリサイド層 121:タンタムシリサイド層
 122:タンタムシリサイド粒子

【図6】



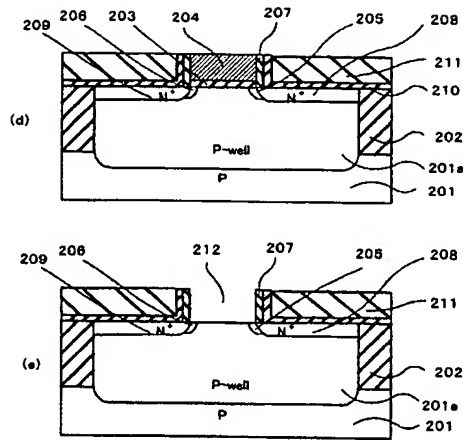
101:シリコン基板 101a:P型ウェル領域 101b:N型ウェル領域
 102:素子分離領域 106, 107:エクステンション領域 108:側壁絶縁膜
 111, 112:ソース及びドレイン領域 113:層間絶縁膜
 114:ゲート絶縁膜 115:第1の金属シリサイド膜 116:バリア金属膜
 117:第1の金属膜 118:第2のキャップ膜 119:第2の金属シリサイド膜
 120:第1のバリア絶縁膜 121:第2のバリア絶縁膜

【図 7】



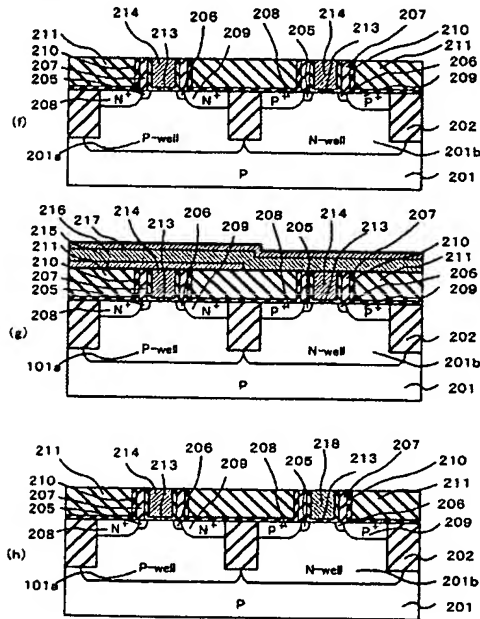
201:シリコン基板 201a:P型ウエル領域 202:素子分離領域
203:絶縁膜 204:導電膜
205, 206:エクステンション領域
207:側壁絶縁膜 208, 209:ソース及びドレイン領域
210:第3のキャップ膜

【図 8】



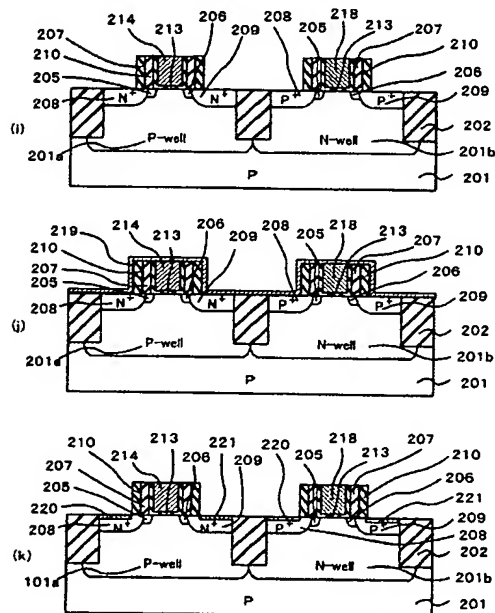
201:シリコン基板 201a:P型ウエル領域 202:素子分離領域
203:絶縁膜 204:導電膜
205, 206:エクステンション領域
207:側壁絶縁膜 208, 209:ソース及びドレイン領域
210:第3のキャップ膜 211:埋め込み絶縁膜 212:空間領域

【図 9】



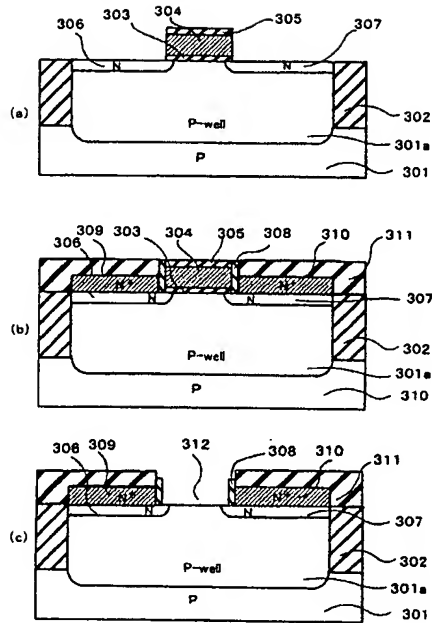
201:シリコン基板 201a:P型ウエル領域 201b:N型ウエル領域
202:素子分離領域 205, 206:エクステンション領域
207:側壁絶縁膜 208, 209:ソース及びドレイン領域
210:第3のキャップ膜 211:埋め込み絶縁膜 213:ゲート絶縁膜
214:第1の金属シリサイド膜 215:パライヤ金属膜
216:第1の金属膜 217:第2のキャップ膜 218:第2の金属シリサイド膜

【図 10】



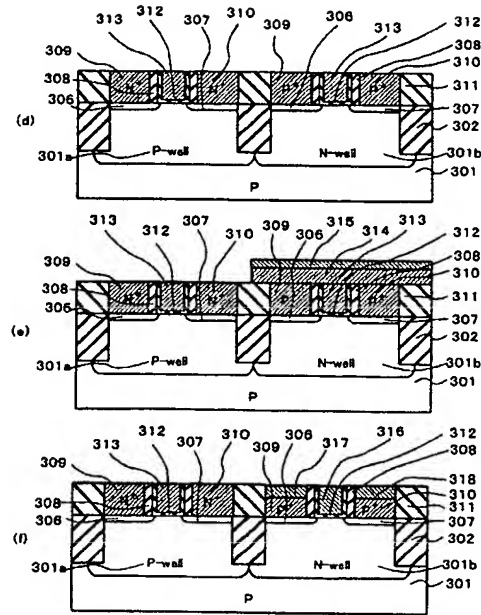
201:シリコン基板 201a:P型ウエル領域 201b:N型ウエル領域
202:素子分離領域 205, 206:エクステンション領域
207:側壁絶縁膜 208, 209:ソース及びドレイン領域
210:第3のキャップ膜 213:ゲート絶縁膜
214:第1の金属シリサイド膜 218:第2の金属シリサイド膜
219:第2の金属膜 220, 221:第2の金属シリサイド電極層

【図 1 1】



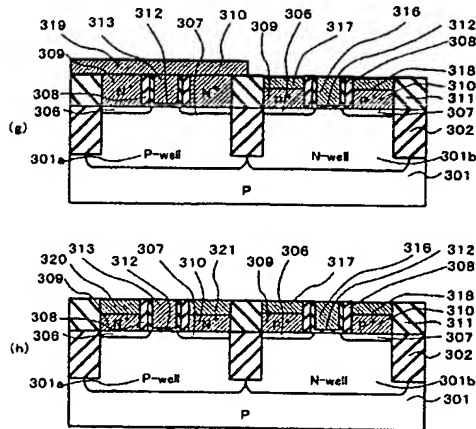
301:シリコン基板 301a:P型ウェル領域 302:素子分離領域
303:絶縁膜 304:導電膜 305:第1のキャップ膜
306, 307:エクステンション領域 308:側壁絶縁膜
309, 310:エレベータッドソース及びエレベータッドドレイン領域
311:層間絶縁膜 308a:空間領域

【図 1 2】



301:シリコン基板 301a:P型ウェル領域 301b:N型ウェル領域
302:素子分離領域 306, 307:エクステンション領域 308:側壁絶縁膜
309, 310:エレベータッドソース及びエレベータッドドレイン領域
311:層間絶縁膜 312:ゲート絶縁膜 313:第1の金属シリサイド膜
314:第1の金属膜 315:第4のキャップ膜 316:第2の金属シリサイド膜
317, 318:第3の金属シリサイド電極層

【図 1 3】



301:シリコン基板 301a:P型ウェル領域 301b:N型ウェル領域
302:素子分離領域 306, 307:エクステンション領域
308:側壁絶縁膜
309, 310:エレベータッドソース及びエレベータッドドレイン領域
311:層間絶縁膜 312:ゲート絶縁膜 313:第1の金属シリサイド膜
316:第2の金属シリサイド膜
317, 318:第3の金属シリサイド電極層
319:第3の金属膜
320, 321:第4の金属シリサイド電極層

フロントページの続き

(51)Int.Cl.

F I

テーマコード (参考)

H 0 1 L	29/49	H 0 1 L	29/78	6 1 3 A
H 0 1 L	29/78	H 0 1 L	27/08	3 2 1 E
H 0 1 L	29/786	H 0 1 L	29/58	G
		H 0 1 L	29/78	6 1 6 A

F ターム (参考) 5F048 AA01 AA07 AC03 BA01 BA16 BB08 BB09 BB10 BB11 BB13
 BB14 BC01 BC06 BD04 BE03 BF01 BF02 BF06 BF07 BG12
 BG13 DA25 DA27 DA30

5F110 AA08 BB04 CC02 DD05 DD13 EE05 EE12 EE22 EE32 EE38
 EE44 EE45 FF01 FF02 FF03 FF04 FF28 FF29 GG02 GG12
 GG31 GG52 HJ01 HJ04 HJ13 HJ23 HK05 HK40 HL02 HL03
 HM02 HM15 NN02 NN23 NN35 NN62 NN66 NN78 QQ19

5F140 AA06 AA26 AB03 AC01 BA01 BC06 BD07 BD09 BD11 BE09
 BE10 BF01 BF08 BF09 BF32 BF37 BF38 BF40 BG04 BG05
 BG09 BG11 BG14 BG28 BG30 BG36 BG40 BG41 BG44 BG45
 BG46 BG52 BG53 BG58 BH06 BH14 BH15 BJ01 BJ08 BK02
 BK05 BK13 BK16 BK18 BK21 BK23 BK25 BK29 BK34 BK38
 BK39 CA03 CA10 CB01 CB04 CB08 CC03 CE07 CE08 CF04

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成17年2月3日(2005.2.3)

【公開番号】特開2004-158593(P2004-158593A)
 【公開日】平成16年6月3日(2004.6.3)
 【年通号数】公開・登録公報2004-021
 【出願番号】特願2002-322094(P2002-322094)
 【国際特許分類第7版】

H 0 1 L 21/8238
 H 0 1 L 21/28
 H 0 1 L 21/336
 H 0 1 L 27/092
 H 0 1 L 29/423
 H 0 1 L 29/49
 H 0 1 L 29/78
 H 0 1 L 29/786

【F I】

H 0 1 L 27/08 3 2 1 D
 H 0 1 L 21/28 3 0 1 S
 H 0 1 L 29/78 3 0 1 G
 H 0 1 L 29/78 3 0 1 P
 H 0 1 L 29/78 6 1 7 M
 H 0 1 L 29/78 6 1 3 A
 H 0 1 L 27/08 3 2 1 E
 H 0 1 L 29/58 G
 H 0 1 L 29/78 6 1 6 A

【手続補正書】
 【提出日】平成16年3月2日(2004.3.2)
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項1】

半導体基体と、

前記半導体基体に設けられ第1及び第2の素子領域を囲む素子分離領域と、

前記第1の素子領域に形成されると共に、少なくともゲート電極膜におけるゲート絶縁膜に接する領域が、第1の金属シリサイドで構成されたNチャネル電界効果トランジスタと

、
 前記第2の素子領域に形成されると共に、ゲート電極膜が、前記第1の金属シリサイドを構成する金属とは異なる金属からなる第2の金属シリサイドと、前記第1の金属シリサイドの構成材料である金属及び前記第1の金属シリサイドと同じ構成材料であり、かつ、前記第1の金属シリサイドよりもシリコン含有量が少ない第3の金属シリサイドから選ばれた少なくとも一方とから構成されたPチャネル電界効果トランジスタを有し、

前記Nチャネル電界効果トランジスタのゲート電極膜の仕事関数が、前記Pチャネル電界効果トランジスタのゲート電極膜の仕事関数よりも小さいことを特徴とする絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置。

【請求項 2】

前記 P チャンネル電界効果トランジスタのゲート電極膜におけるゲート絶縁膜に接する領域が、前記第 1 の金属シリサイドを構成する金属とは異なる金属からなる第 2 の金属シリサイドと、前記第 1 の金属シリサイドの構成材料である金属及び前記第 1 の金属シリサイドと同じ構成材料であり、かつ、前記第 1 の金属シリサイドよりもシリコン含有量が少ない第 3 の金属シリサイドから選ばれる少なくとも一方とから構成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置。

【請求項 3】

前記 P チャンネル電界効果トランジスタのゲート電極膜におけるゲート絶縁膜に接する領域が、前記第 1 の金属シリサイドの構成材料である金属、及び前記第 1 の金属シリサイドと同じ構成材料であり、かつ、前記第 1 の金属シリサイドよりもシリコン含有量が少ない第 3 の金属シリサイドから選ばれる少なくとも一方とから構成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置。

【請求項 4】

半導体基体上に素子分離領域を形成して、前記素子分離領域に囲まれる N チャンネル電界効果トランジスタ領域、及び前記素子分離領域に囲まれる P チャンネル電界効果トランジスタ領域を形成する工程と、
前記半導体基体上に絶縁膜を形成する工程と、
前記絶縁膜上に導電膜を形成する工程と、
前記導電膜を選択的にパターニングしてゲート領域を形成する工程と、
パターニングされた前記導電膜に対して自己整合的に、前記 N チャンネル電界効果トランジスタ領域及び前記 P チャンネル電界効果トランジスタ領域にソース及びドレイン領域を形成する工程と、
前記導電膜の周囲に側壁絶縁膜を形成する工程と、
前記ゲート領域の前記導電膜及び前記絶縁膜を除去し、前記側壁絶縁膜に囲まれる空間領域を形成する工程と、
前記空間領域に囲まれた前記 N チャンネル電界効果トランジスタ領域及び前記 P チャンネル電界効果トランジスタ領域上にゲート絶縁膜を形成する工程と、
前記空間領域内の前記ゲート絶縁膜上に第 1 の金属シリサイド膜を形成する工程と、
前記 P チャンネル電界効果トランジスタ領域上に、前記第 1 の金属シリサイド膜を構成する金属とは異なる金属膜を形成する工程と、
前記 P チャンネル電界効果トランジスタ領域の第 1 の金属シリサイド膜を、前記第 1 の金属シリサイドを構成する金属とは異なる金属からなる第 2 の金属シリサイド、及び前記第 1 の金属シリサイドの構成材料である金属並びに前記第 1 の金属シリサイドと同じ構成材料であり、かつ、前記第 1 の金属シリサイドよりもシリコン含有量が少ない第 3 の金属シリサイドから選ばれる少なくとも一種とで構成された膜に変換する熱処理の工程とを有することを特徴とする絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法。

【請求項 5】

前記第 1 の金属シリサイドとして、単位体積当りのシリコンの原子数が、単位体積当りの金属の原子数の 2.5 倍以上である膜を形成することを特徴とする請求項 4 に記載の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含む半導体装置の製造方法。